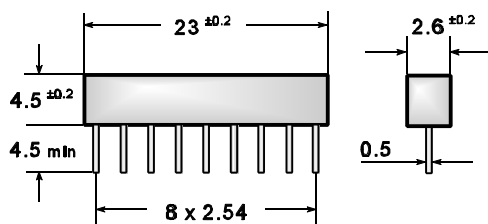


Fast Switching Rectifier Arrays
Schnelle Gleichrichter Sätze


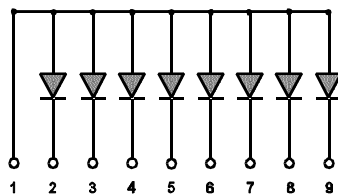
Dimensions / Maße in mm

 Nominal power dissipation 1.2 W
 Nenn-Verlustleistung

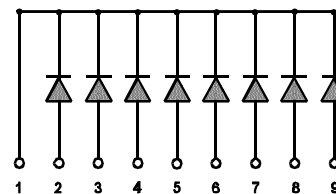
 Repetitive peak reverse voltage 100...1000 V
 Periodische Spitzensperrspannung

 9 Pin-Plastic case 23 x 2.6 x 4.5 [mm]
 9 Pin-Kunststoffgehäuse

 Standard packaging: bulk
 Standard Lieferform: lose im Karton

 Weight approx. 0,6 g
 Gewicht ca.


"DAF 811 A...8110 A": com. anodes / gem. Anode



"DAF 811 K...8110 K" : com. kathodes / gem. Kathode

Maximum ratings
Grenzwerte

Type	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Typ	Periodische Spitzensperrspannung	Stoßspitzensperrspannung
	V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]
DAF 811 A/K	100	120
DAF 814 A/K	400	480

Max. average forward rectified current, R-load, For one diode operation only	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV}	600 mA ¹⁾
For all diodes together		I_{FAV}	150 mA ¹⁾

Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last, Nur eine Diode im Einsatz	$T_U = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV}	600 mA ¹⁾
Für alle Dioden zusammen		I_{FAV}	150 mA ¹⁾

Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave, superimposed on rated load, one diode only	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	30 A
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen, überlagert bei Nennlast, für eine Diode			

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Max. power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	1.2 W ¹⁾
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	- 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	- 50...+150°C

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1 \text{ A}$	V_F	< 1.1 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{\text{RRM}}$ $V_R = V_{\text{RRM}}$	I_R I_R	< 10 μA < 90 μA
Reverse recovery time Sperrverzug		$I_F = 10 \text{ mA}$ through/über $I_R = 10 \text{ mA}$ to/auf $I_R = 1 \text{ mA}$	t_{rr}	< 350 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 85 K/W ¹⁾

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden